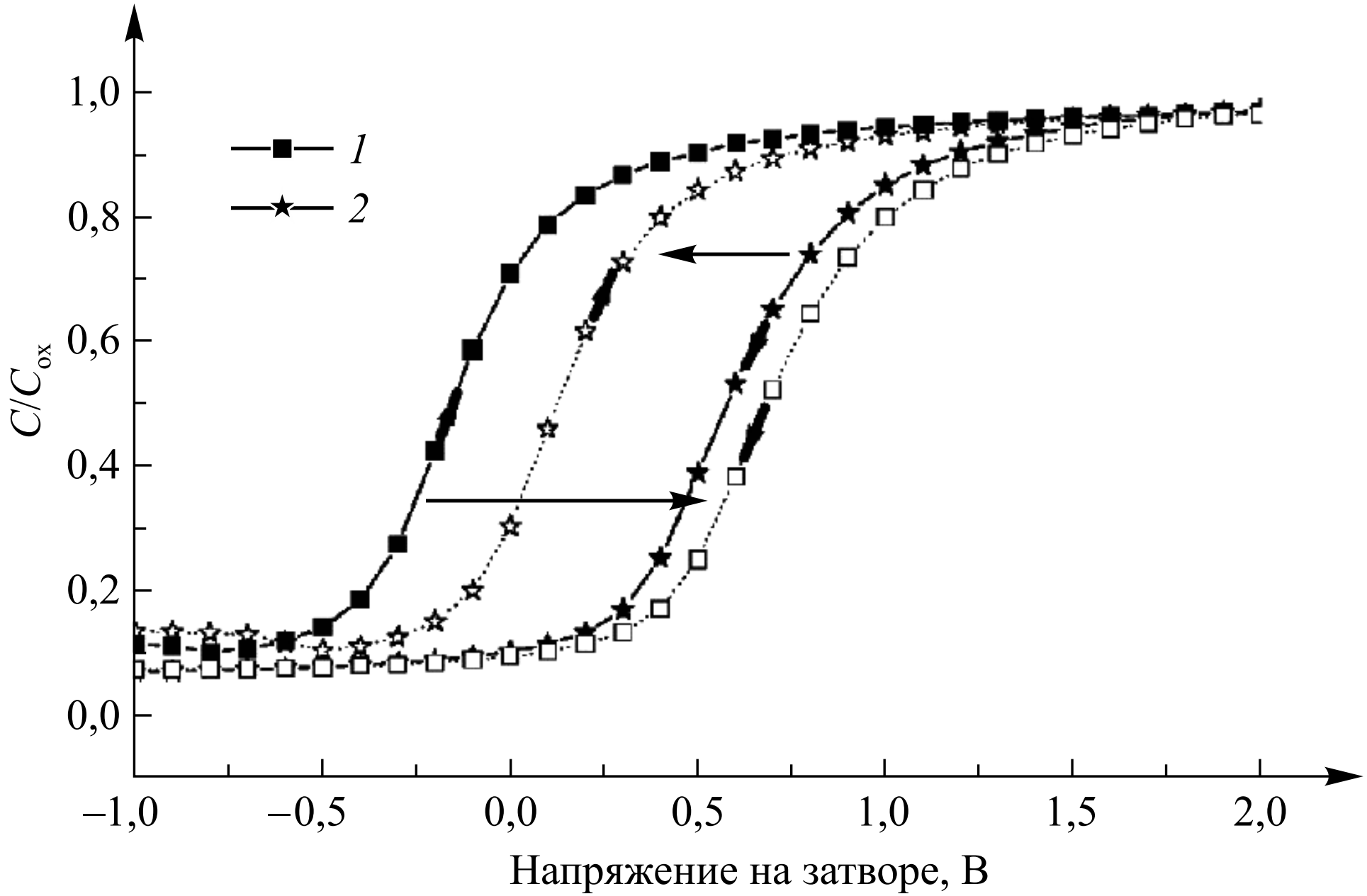

Рис. 6. Типичные вольт-фарадные характеристики МОП-структуры с матрицей нанокристаллов Ge в слое SiO_2 при изменении напряжения: *1* – от +5 до –5 В и от –5 до +5 В; *2* – от –5 до +5 В и от +5 до –5 В

Fig. 6. Typical capacitor-voltage characteristics of a MOS structure Ge nanocrystals matrix in the SiO_2 layer when voltage changes: from +5 to –5 V and from –5 to +5 V; *2* – from –5 to +5 V and from +5 to –5 V